

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Химический факультет



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. декана ХФ

А.С. Князев

08 20 22 г.

Фонд оценочных средств

Кристаллохимия

по специальности

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

Специализация:

«Фундаментальная и прикладная химия»

Форма обучения

Очная

Квалификация

Химик. Преподаватель химии

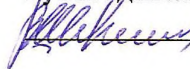
Год приема

2022

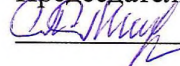
Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.1.11

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

 В.В. Шелковников

Председатель УМК

 Л.Н. Мишенина

Томск – 2022

1 Паспорт фонда оценочных средств

Направление подготовки	04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
Дисциплина	Кристаллохимия
Семестр обучения	5
Общий объем дисциплины, ЗЕ	4
Формы текущего контроля	Устный опрос на семинарских занятиях, выполнения письменных заданий на семинарских занятиях, 2 коллоквиума, 1 индивидуальное задание
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе и промежуточная аттестация.

2 Перечень формируемых компетенций и уровни их освоения

Изучение дисциплины «Неорганическая химия» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды и содержание компетенций по СУОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ООП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
ОПК -1 Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической направленности.	ИОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов. ИОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ с использованием теоретических основ традиционных и новых разделов химии.	<i>Допороговый уровень</i>	<i>Знает:</i> основы описания кристаллических структур и теоретической кристаллохимии, но допускает грубые ошибки
		<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знает:</i> основы описания кристаллических структур и теоретической кристаллохимии <i>Умеет:</i> выполнять стандартные действия (определять элементы симметрии молекул, многогранников и кристаллических структур, строить кристаллографическую проекцию, описывать кристаллические структуры с точки зрения теоретической кристаллохимии, определять связь строения с физическими свойствами веществ и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках дисциплины

Коды и содержание компетенций по СУОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ООП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
	ИОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической направленности.		кристаллохимия, но допускает незначительные ошибки.
		<i>Достаточный уровень</i>	<p><i>Знает:</i> основы описания кристаллических структур и теоретической кристаллохимии</p> <p><i>Умеет:</i> выполнять стандартные действия (определять элементы симметрии молекул, многогранников и кристаллических структур, строить кристаллографическую проекцию, описывать кристаллические структуры с точки зрения теоретической кристаллохимии, определять связь строения с физическими свойствами веществ и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках дисциплины кристаллохимия.</p> <p><i>Владеть (обладать навыками):</i> навыками работы с учебной, справочной и периодической литературой по основным разделам кристаллохимии.</p>
		<i>Продвинутый уровень</i>	<p><i>Знает:</i> основы описания кристаллических структур и теоретической кристаллохимии</p> <p><i>Умеет:</i> выполнять стандартные действия (определять элементы симметрии молекул, многогранников и кристаллических структур, строить кристаллографическую проекцию, описывать</p>

Коды и содержание компетенций по СУОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ООП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
			<p>кристаллические структуры с точки зрения теоретической кристаллохимии, определять связь строения с физическими свойствами веществ и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках дисциплины.</p> <p>кристаллохимия.</p> <p><i>Владеть (обладать навыками):</i> навыками анализа учебной, справочной и периодической информации по основным разделам дисциплины, способен формулировать выводы и участвовать в дискуссии по учебным вопросам.</p>
<p>ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники.</p>	<p>ИОПК 3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические модели при решении задач химической направленности.</p>	<p><i>Допороговый уровень</i></p>	<p><i>Уметь:</i> не умеет применять теоретические модели для описания кристаллических структур.</p>
		<p><i>Пороговый уровень</i></p>	<p><i>Знает:</i> теоретические модели для описания кристаллических структур. <i>Умеет:</i> применять теоретические модели для описания кристаллических структур и свойств неорганических соединений, но допускает несущественные ошибки.</p>
		<p><i>Достаточный уровень</i></p>	<p><i>Знает:</i> теоретические модели для описания кристаллических структур. <i>Умеет:</i> применять теоретические модели для описания кристаллических структур и свойств</p>

Коды и содержание компетенций по СУОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ООП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
			неорганических соединений. <i>Владеет:</i> навыками выбора метода описания кристаллических структур неорганических соединений.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знает:</i> теоретические модели для описания кристаллических структур. <i>Умеет:</i> применять теоретические модели для описания кристаллических структур и свойств неорганических соединений. <i>Владеет:</i> навыками выбора метода описания кристаллических структур неорганических соединений, способен установить взаимосвязь свойств веществ и их строения.

Уровни и шкала оценивания сформированности компетенций

Допороговый уровень	Соответствует оценке «неудовлетворительно», предполагает несформированность компетенций на достаточном уровне. Студент имеет пробелы по отдельным теоретическим разделам и не владеет основными умениями и навыками.
Пороговый уровень	Соответствует оценке «удовлетворительно», предполагает сформированность компетенций на достаточном уровне. Студент имеет недостаточно глубокие знания по отдельным теоретическим разделам, показал не все основные умения и навыки.
Достаточный уровень	Соответствует оценке «хорошо», предполагает сформированность компетенций на достаточно хорошем уровне. Студент изучил все теоретические вопросы, показал основные умения и навыки.
Продвинутый уровень	Соответствует оценке «отлично», предполагает сформированность компетенций на высоком уровне. Студент показал творческое отношение к обучению, в совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами дисциплины, показал все требуемые умения и навыки.

2 Этапы формирования компетенций и оценочные средства (текущая аттестация)

2.1 Виды оценочных средств

№	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Код индикатора достижения компетенции согласно ОПП
1	Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия кристаллохимии	Тестирование	ИОПК 1.1., ИОПК 3.1
2	Тема 2. Группы симметрии и структурные классы	Тестирование Коллоквиум №1 Коллоквиум №2	ИОПК 1.1., ИОПК 1.3.
3	Тема 3. Общая кристаллохимия	Тестирование Индивидуальное задание	ИОПК 1.1., ИОПК 1.3.
4	Тема 4. Основные категории теоретической кристаллохимии	Тестирование Индивидуальное задание	ИОПК 1.1., ИОПК 1.3.
5	Тема 5. Важнейшие структурные типы	Тестирование индивидуальное задание	ИОПК 1.1., ИОПК 1.2., ИОПК 3.1
6	Тема 6. Прикладные аспекты кристаллохимии	Тестирование	ИОПК 1.2., ИОПК 3.1

2.2 Содержание оценочных средств

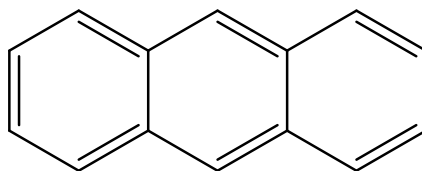
Вопросы для подготовки к коллоквиуму №1 по теме «Группы симметрии и структурные классы»

1. Понятие точечной группы. Симметричные операции и элементы симметрии. Центр симметрии, плоскость симметрии, поворотные, зеркально-поворотные и инверсионные оси.
2. Семейства точечных групп низшей, средней и высшей категории. Предельные группы категорий.
3. Взаимодействие элементов симметрии (теоремы).
4. Стереографическая проекция элементов симметрии и нормалей к граням многогранников.
5. Символика точечных групп. Символы Германа-Могена и Шенфлиса.
6. Структурные классы молекул.

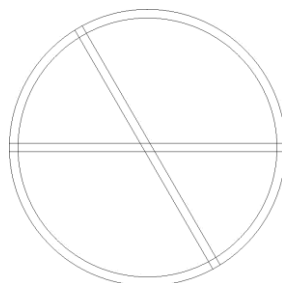
Пример билета коллоквиума №1

Вариант 1

1. Дайте определение симметричной фигуры и симметричного преобразования.
2. Опишите обозначение групп симметрии по Шёнфлису кристаллов без единичного направления.
3. Обозначьте элементы симметрии плоской молекулы. Запишите обозначение элементов симметрии по Бравэ.



4. Выведите полный набор элементов симметрии и определите категорию точечной группы:



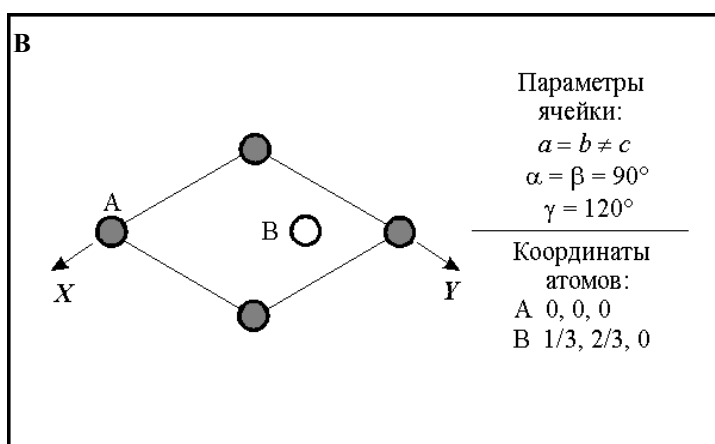
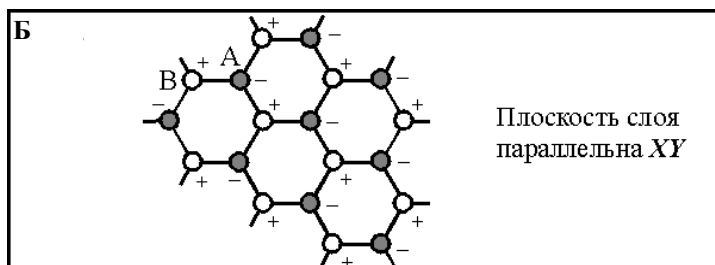
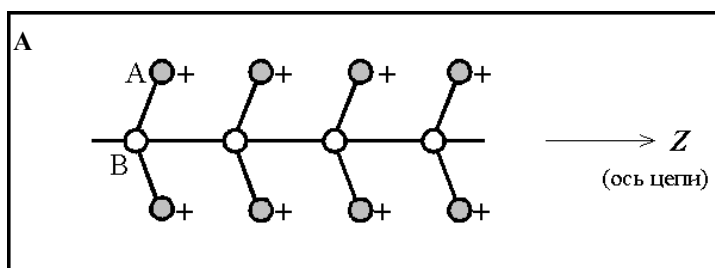
5. Используя модель молекулы и многогранника:
- назовите элементы симметрии, напишите формулу симметрии по Бравэ;
 - укажите категорию, сингонию и вид симметрии;
 - запишите обозначение класса симметрии по Шенфлису и Герману-Могену;
 - нанесите элементы симметрии на проекцию.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму №2 по теме «Открытые элементы симметрии. Симметрия кристаллических структур»

1. Группы трансляций. Кристаллическая решетка и кристаллическая структура.
2. Симметрия решетки. Кристаллографические координатные системы. Элементарная ячейка.
3. Симметрия кристаллического многогранника и симметрия позиций в кристаллической структуре.
4. Открытые элементы симметрии кристаллических структур и их обозначения.
5. Типы решеток. Структуры Бравэ.
6. Сочетания открытых и закрытых элементов симметрии между собой и с перпендикулярными трансляциями.
7. Пространственные группы симметрии для низшей, средней и высшей категорий. Структурные классы.
8. Структурные классы цепей и слоев.

Пример билета коллоквиума №2

1. Дайте определение координатной плоскости скользящего отражения, поясните ее действие.
2. Пространственные группы симметрии для кристаллов средней категории, их классификация и обозначения.
3. Запишите структурные классы цепи (А), слоя (Б) и кристаллической структуры (В), проекции которых показаны на рисунках. Во всех случаях рассмотрите два варианта: А и В – атомы разных элементов, А и В – атомы одного элемента. Обоснованием решения является изображение расположения важнейших элементов симметрии на фоне расположения атомов.



Содержание индивидуального задания по теме «Важнейшие структурные типы сложных веществ»

1. Словесное описание структуры.
2. Кристаллографическое описание:
 - определить ячейку Бравэ;
 - подсчитать число атомов различного типа, которое приходится на ячейку Бравэ, определить кристаллохимическую формулу соединения, число формульных единиц;
 - определить взаимную координацию атомов, координационное число и координационный полиэдр для каждого сорта атомов.
3. Кристаллохимическое описание:
 - описать структуру в терминах плотнейших шаровых упаковок, если это возможно;
 - указать характер сочленения разнообразных структурных фрагментов;
 - пояснить распределение атомов определенного сорта по кристаллографическим позициям;
 - указать минералы, кристаллизующиеся в данном структурном типе;
 - указать на возможный изоморфизм атомов в конкретных структурных позициях;
 - указать типы химических связей между атомами.

Список структур: CsCl, NaCl, ZnS (сфалерит и вюрцит), NiAs, CaF₂, TiO₂, CdI₂, CdCl₂, KClO₄, CaCO₃ (кальцит и арагонит), квасцы. Структурный тип шпинели AB₂O₄, структурный тип перовскита ABO₃. Силикаты и алюмосиликаты.

Примеры тестовых заданий

Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.

1. Линия, при повороте вокруг которой на определенный угол, кристалл совмещается сам с собой, называется:

- А) плоскость симметрии
- Б) ось симметрии
- В) центр симметрии
- Г) зеркально-поворотная ось

2. В объемцентрированной кубической упаковке шары занимают:

- А) 55 % пространства
- Б) 58 % пространства
- В) 75 % пространства
- Г) 68 % пространства

3. Степень сопротивления кристалла внешнему воздействию называется:

- А) упругость
- Б) плотность
- В) сжимаемость
- Г) твердость

4. Физические свойства, величина которых не зависит от направления, в котором они определяются, называются:

- А) скалярные
- Б) векторные
- В) тензорные
- Г) независимые

Выберите несколько правильных ответов из числа предложенных вариантов.

1. Какие из приведенных утверждений справедливы для плотнейшей гексагональной шаровой упаковки?

- А) упаковка трехслойная
- Б) упаковка двухслойная
- В) коэффициент заполнения пространства 75 %
- Г) шары третьего слоя находятся над пустотами первого
- Д) третий слой точно повторяет первый

2. Гомодесмические структуры образуют:

- А) координационные структуры
- Б) слоистые структуры
- В) каркасные структуры
- Г) цепочечные структуры
- Д) островные структуры

3. При образовании изоморфного кристалла выполняются следующие правила:

А) радиусы взаимозамещающихся структурных единиц различаются не более чем на 15 %

Б) ион с большим радиусом будет входить в общую кристаллическую структуру легче, чем ион с меньшим радиусом, занимающий ту же позицию

- В) кристаллические структуры компонентов схожи
- Г) заряды взаимозамещающих ионов различаются больше чем на 1
- Д) поляризационные свойства ионов схожи

4. При образовании изоморфного кристалла выполняются следующие правила:

- А) радиусы взаимозамещающихся структурных единиц различаются не более чем на 25 %
- Б) ион с меньшим радиусом будет входить в общую кристаллическую структуру легче, чем ион с большим радиусом, занимающий ту же позицию
- В) кристаллические структуры компонентов различны
- Г) заряды взаимозамещающих ионов различаются не больше чем на 1
- Д) поляризационные свойства ионов схожи

Расположите вещества в порядке, соответствующем изменению их свойств.

1. Расположите следующие вещества в порядке увеличения их температуры плавления:
- А) CaSO_4
- Б) MgSO_4
- В) BeSO_4
- Г) SrSO_4
2. Расположите дефекты кристаллической структуры по увеличению их размерности:
- А) линейные
- Б) точечные
- В) искажения кристаллической решетки
- Г) поверхностные
3. Расположите простые формы низших категорий в порядке увеличения числа граней:
- А) моноэдр
- Б) ромбическая пирамида
- В) ромбическая призма
- Г) пинакоид

Найдите соответствие между элементами двух множеств.

1. Укажите соответствие между значением координационного числа и координационным полиэдром:
- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 1) 20 | А) трехшапочная тригональная призма |
| 2) 14 | Б) икосаэдр |
| 3) 12 | В) пентагондодекаэдр |
| 4) 9 | Г) ромбододекаэдр |
2. Укажите соответствие между видом симметрии и совокупностью элементов симметрии:
- | | |
|----------------|--------------|
| 1) примитивный | А) L_66P |
| 2) центральный | Б) L_66L_2 |
| 3) планальный | В) L_6 |
| 4) аксиальный | Г) L_6PC |

Внесите дополнения в текстовые фразы, путем вписывания в поле для ввода слова, символа или знака.

Впишите слово в именительном падеже.

1. Группа видов симметрии, обладающих одним или несколькими сходными элементами симметрии (с обязательным учетом осей симметрии порядка, выше двух при одинаковом числе единичных направлений) называется *сингония*
2. Твердое тело, обладающее трехмерной периодической атомной (или молекулярной) структурой и, при определенных условиях образования, имеющее естественную форму правильных симметричных многогранников называется *кристалл*

3. Резкое изменение кристаллической структуры в закономерном ряду химических соединений при сохранении количественного соотношения структурных единиц называется *морфотропия*

Оценочные материалы в полном объеме содержатся в содержатся в Учебно-методических комплексах преподавателей, работающих по этой дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=26193>

б) Мишенина Л.Н., Селюнина Л.А. Кристаллохимия. УМП для студентов химического факультета. – Томск.: Издательский Дом ТГУ, 2016. – 48 с.

в) Электронная библиотека ТГУ (доступно читателям НБ ТГУ)

2.3 Методические рекомендации

2.3.1 Порядок проведения текущего контроля

Текущий контроль осуществляется на протяжении периода обучения по дисциплине в рамках организации и проведения лекционных занятий, практических занятий, лабораторных работ, самостоятельной работы студентов и оценивается в 253 балла.

2.3.2 Критерии оценивания по видам оценочных средств

Критерии оценивания коллоквиума №1

Коллоквиум проводится преподавателем, ведущим семинарские занятия по дисциплине. Во время сдачи коллоквиума обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины. Время подготовки ответа должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. Преподавателю предоставляется право задать дополнительные вопросы в рамках текущего раздела программы. Оценка результатов устного коллоквиума объявляется сразу после окончания ответа.

Коллоквиум оценивается в 45 баллов.

Вопросы 1 и 2. Максимальная оценка 5 баллов.

5 баллов – ответ полный, краткий, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией, имеет четкое представление об излагаемом вопросе.

4 балла – ответ полный, краткий, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией, имеет некоторые недочеты в представлении об излагаемом вопросе.

3 балла – ответ неполный, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией.

2 балла – ответ неполный, изложен без четкого знания терминологии.

1 балл – ответ неполный, изложен без четкого знания терминологии, имеет существенные искажения правильности изложения материала.

0 баллов – нет ответа.

Вопрос 3. Максимальная оценка 5 баллов.

5 баллов – верно определены и обозначены все элементы симметрии и записана формула симметрии по Бравэ.

4 балла – верно определены и обозначены все элементы симметрии и записана формула симметрии по Бравэ, но есть неточности, которые обучающийся уверенно исправляет после вопроса преподавателя.

3 балла – верно определены элементы симметрии, но не все они верно обозначены или с ошибками записана формула симметрии по Бравэ, недочеты обучающийся уверенно исправляет после вопроса преподавателя.

2 балла – есть ошибки в определении, обозначении и/или записи формулы симметрии Бравэ (2 ошибки), которые обучающийся исправляет после вопроса преподавателя.

1 балл – есть ошибки в определении, обозначении и/или записи формулы симметрии Бравэ (3 ошибки), которые обучающийся исправляет после вопроса преподавателя.

0 баллов – нет ответа.

Вопрос 4. Максимальная оценка 6 баллов.

6 баллов – верно определены и обозначены на проекции все элементы симметрии и записана формула симметрии по Бравэ, определена категория точечной группы. Ответ уверенно обоснован.

5 балла – верно определены и обозначены все элементы симметрии и записана формула симметрии по Бравэ, определена категория точечной группы, но есть неточности, которые обучающийся уверенно исправляет после вопроса преподавателя.

4-3 балла – верно определены элементы симметрии, но не все они верно обозначены и/или с ошибками записана формула симметрии по Бравэ, определена категория точечной группы, недочеты обучающийся уверенно исправляет после вопроса преподавателя.

2 балла – есть ошибки в определении, обозначении и/или записи формулы симметрии Бравэ, определении категории точечной группы (2 ошибки), которые обучающийся исправляет после вопроса преподавателя.

1 балл – есть ошибки в определении, обозначении и/или записи формулы симметрии Бравэ определении категории точечной группы (3 ошибки), которые обучающийся исправляет после вопроса преподавателя.

0 баллов – нет ответа.

Вопрос 5. Максимальная оценка 24 балла (12 баллов за работу с молекулой, 12 баллов за работу с многогранником).

Оценка равная 12 баллам состоит из:

5 баллов – за определение элементов симметрии, запись формулы симметрии по Бравэ;

1 балл – за определение категории, сингонии и вида симметрии;

2 балла – за запись обозначения по Шенфлису;

2 балла – за запись обозначения по Герману-Могену;

2 балла – за построение стереографической проекции.

При недостатках в ответе баллы снижаются или не выставляются за каждый критерий оценивания.

Критерии оценивания результатов коллоквиума №2

Коллоквиум проводится преподавателем, ведущим семинарские занятия по дисциплине. Во время сдачи коллоквиума обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины. Время подготовки ответа должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. Преподавателю предоставляется право задать дополнительные вопросы в рамках текущего раздела программы. Оценка результатов устного коллоквиума объявляется сразу после окончания ответа.

Коллоквиум оценивается в 45 баллов.

Вопросы 1 и 2. Максимальная оценка 6 балла.

6 баллов – ответ полный, краткий, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией, имеет четкое представление об излагаемом вопросе.

5-4 балла – ответ полный, краткий, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией, имеет некоторые недочеты в представлении об излагаемом вопросе.

3 балла – ответ неполный, правильный ответ, изложенный грамотным химическим языком, студент владеет терминологией.

2 балла – ответ неполный, изложен без четкого знания терминологии.

1 балл – ответ неполный, изложен без четкого знания терминологии, имеет существенные искажения правильности изложения материала.

0 баллов – нет ответа.

Вопрос 3. Максимальная оценка 36 баллов (по 12 баллов за определение структурных классов цепи (А), слоя (В) и кристаллической структуры (В)).

Оценка равная 12 баллам состоит из 6 баллов за определение структурного класса при А и В – атомы разных элементов и А и В – атомы одного элемента:

2 балла – за определение элементов симметрии;

2 балла – за изображение расположения важнейших элементов симметрии на фоне расположения атомов;

2 балла – за запись обозначения по Герману-Могену;

При недостатках в ответе баллы снижаются или не выставляются за каждый критерий оценивания.

Критерии оценивания индивидуального задания:

1. Словесное описание структуры (1 б.).

2. Кристаллографическое описание:

- определить категорию и сингонию (1 б);
- определить ячейку Бравэ (1 б);
- записать пространственную группу симметрии в международной символике (3 б);
- привести проекцию элементарной ячейки с изображением всех элементов симметрии (5 б);
- подсчитать число атомов различного типа, которое приходится на ячейку Бравэ, определить кристаллохимическую формулу соединения, число формульных единиц (3 б);
- определить взаимную координацию атомов, координационное число и координационный полиэдр для каждого сорта атомов (3 б);

3. Кристаллохимическое описание:

- описать структуру в терминах плотнейших шаровых упаковок, если это возможно (3 б);
- указать характер сочленения разнообразных структурных фрагментов (3 б);
- пояснить распределение атомов определенного сорта по кристаллографическим позициям (3 б);
- указать минералы, кристаллизующиеся в этом структурном типе (1 б);
- указать на возможный изоморфизм атомов в конкретных структурных позициях (1 б);
- указать типы химических связей между атомами (2 б).

При недостатках в ответе баллы снижаются или не выставляются за каждый критерий оценивания.

3 Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

3.1 Порядок проведения экзамена

Экзамен в пятом семестре проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух частей. Продолжительность экзамена 1,5 часа, из них 1 час на подготовку ответа, 30 минут на устный ответ.

Первая часть содержит два вопроса, проверяющие ИОПК 1.1 и ИОПК 1.3. Ответ на вопрос первой части даётся в развёрнутой форме. Содержание вопросов соответствует содержанию дисциплины (п.8).

Вторая часть содержит задание, проверяющее ИОПК 3.1, и оформленное в виде практического задания.

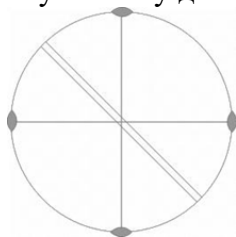
Примеры экзаменационных билетов

Экзаменационный билет №1

1. Понятие о симметрии. Симметричная фигура, симметричное преобразование. Чем различаются операции симметрии первого и второго рода? Перечислите их. Почему в кристаллах встречаются поворотные оси строго определенных порядков?

2. Критерии устойчивости структурного типа. Правила Полинга. Возможно ли применение правил Полинга (если, да, то каких), для структур с существенной долей ковалентности связи.

3. Выведите полный набор элементов симметрии, нанесите их на проекцию, определите категорию и сингонию, запишите обозначение класса симметрии по Шенфлису и Герману-Могену для точечной группы:

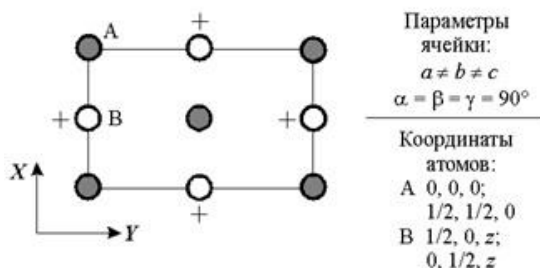


Экзаменационный билет №2

1. Точечные группы геометрических фигур и молекул. Симметрия правильных многогранников. Порядок записи элементов симметрии в символике Бравэ. Как определить наличие в плоской и объемной фигуре центра симметрии?

2. Изоморфизм. Типы изоморфизма. Опишите возможные схемы гетеровалентных замещений без изменения общего числа атомов в элементарной ячейке.

3. Запишите пространственную группу кристаллической структуры в символике Германа-Могена, определите категорию и сингонию, используя проекцию, изобразите элементы симметрии на фоне расположения атомов:



Критерии оценивания

Максимальный балл за экзамен – 140, 1 и 2 вопрос оценивается в 50 баллов, 3 вопрос – 40 баллов. Общий балл за экзамен выставляется суммированием баллов, полученных на ответы на 1, 2 и 3 вопросы.

Критерии оценивания 1 и 2 вопросов:

50-42. Полный безошибочный ответ с правильным применением понятий и определений, с грамотным использованием необходимых терминов и понятий.

41-33. Правильный и достаточно полный, не содержащий существенных ошибок ответ. Оценка может быть снижена за отдельные несущественные ошибки.

32-24. Недостаточно полный объем ответа, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях.

24-16. Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях.

15-0. Отсутствие необходимых знаний, отрывочный, поверхностный ответ.

Итоговая оценка определяется как суммирование баллов за ответы на 3 экзаменационных вопроса.

Критерии оценивания 3 вопроса:

40-34. Верно определен и записан в указанной символике полный набор элементов симметрии, все элементы обозначены, определена категория и сингония.

33-27. Неверно определен один из указанных пунктов.

26-20. Неверно определен или отсутствует один из указанных пунктов.

19-13. Неверно определены или отсутствуют два из указанных пунктов.

12-0. Неверно определены или отсутствуют три из указанных пунктов.

Результаты дисциплины определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка учитывает результаты экзамена и рейтинга семестра: суммарный рейтинг курса – 393 балла.

Соответствие баллов экзаменационной оценке:

393 – 314 баллов – «отлично» (80%)

313 – 255 баллов – «хорошо» (65%)

254 – 197 баллов – «удовлетворительно» (50%)

4 Оценочные средства для контроля остаточных знаний

Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.

1. Линия, при повороте вокруг которой на определенный угол, кристалл совмещается сам с собой, называется:

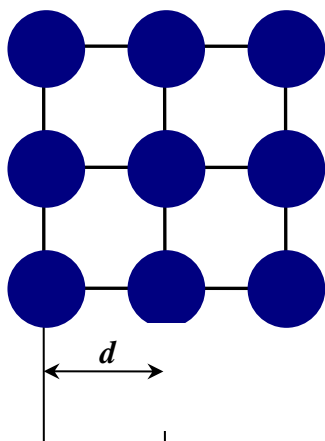
- А) плоскость симметрии
- Б) ось симметрии
- В) центр симметрии
- Г) зеркально-поворотная ось

2. Точка внутри кристалла, по обе стороны от которой на равных расстояниях встречаются одинаковые точки кристалла, называется:

- А) плоскость симметрии
- Б) ось симметрии
- В) центр симметрии

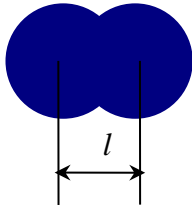
3. Эффективный радиус атома, который определяется как половина расстояния между соседними атомами, полученного в результате рентгеноструктурного анализа,

$r = \frac{d}{2}$, называется:



- А) Ван-дер-ваальсов
- Б) ионный
- В) металлический
- Г) ковалентный

4. Эффективный радиус атома, который определяется как половина межатомного расстояния (длины связи), $r = \frac{l}{2}$, называется:



- А) Ван-дер-ваальсов
- Б) ионный
- В) металлический
- Г) ковалентный

5. В объемцентрированной кубической упаковке шары занимают:

- А) 55 % пространства
- Б) 58 % пространства
- В) 75 % пространства
- Г) 68 % пространства

6. В кубической плотнейшей упаковке шары занимают:

- А) 55 % пространства
- Б) 58 % пространства
- В) 75 % пространства
- Г) 68 % пространства

7. Степень сопротивления кристалла внешнему воздействию называется:

- А) упругость
- Б) плотность
- В) сжимаемость
- Г) твердость

8. Физические свойства, величина которых не зависит от направления, в котором они определяются, называются:

- А) скалярные
- Б) векторные
- В) тензорные
- Г) независимые

9. Число формульных единиц в кристаллической структуре хлорида натрия равно:

- А) 2
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8

10. Число формульных единиц в кристаллической структуре сфалерита равно:

- А) 2
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8

Выберите несколько правильных ответов из числа предложенных вариантов.

1. Какие из приведенных утверждений справедливы для плотнейшей кубической шаровой упаковки?

- А) упаковка трехслойная

- Б) упаковка двухслойная
 - В) коэффициент заполнения пространства 75 %
 - Г) шары третьего слоя находятся над пустотами первого
 - Д) третий слой точно повторяет первый
2. Какие из приведенных утверждений справедливы для плотнейшей гексагональной шаровой упаковки?
- А) упаковка трехслойная
 - Б) упаковка двухслойная
 - В) коэффициент заполнения пространства 75 %
 - Г) шары третьего слоя находятся над пустотами первого
 - Д) третий слой точно повторяет первый
3. Гомодесмические структуры образуют:
- А) координационные структуры
 - Б) слоистые структуры
 - В) каркасные структуры
 - Г) цепочечные структуры
 - Д) островные структуры
4. Гетеродесмические структуры образуют:
- А) координационные структуры
 - Б) слоистые структуры
 - В) каркасные структуры
 - Г) цепочечные структуры
 - Д) островные структуры
5. При образовании изоморфного кристалла выполняются следующие правила:
- А) радиусы взаимозамещающихся структурных единиц различаются не более чем на 15 %
 - Б) ион с большим радиусом будет входить в общую кристаллическую структуру легче, чем ион с меньшим радиусом, занимающий ту же позицию
 - В) кристаллические структуры компонентов схожи
 - Г) заряды взаимозамещающих ионов различаются больше чем на 1
 - Д) поляризационные свойства ионов схожи
6. При образовании изоморфного кристалла выполняются следующие правила:
- А) радиусы взаимозамещающихся структурных единиц различаются не более чем на 25 %
 - Б) ион с меньшим радиусом будет входить в общую кристаллическую структуру легче, чем ион с большим радиусом, занимающий ту же позицию
 - В) кристаллические структуры компонентов различны
 - Г) заряды взаимозамещающих ионов различаются не больше чем на 1
 - Д) поляризационные свойства ионов схожи
7. К пяти правилам Полинга строения ионных кристаллов относятся:
- А) расстояние катион – анион в координационном полиэдре определяется суммой ионных радиусов, а координационное число их отношением
 - Б) сумма валентных усилий анионов, сходящихся на анионах, должна быть численно равна или почти равна валентности катиона
 - В) устойчивость структуры повышается при наличии общих граней и ребер координационных полиэдров
 - Г) высоко ковалентные и особенно маленькие по размеру катионы стремятся не иметь общих анионов
 - Д) число разных по конституции структурных фрагментов стремится к минимуму
8. К пяти правилам Полинга строения ионных кристаллов относятся:
- А) расстояние катион – анион в координационном полиэдре определяется суммой ионных радиусов, а координационное число их отношением

Б) сумма валентных усилий катионов, сходящихся на анионах, должна быть численно равна или почти равна валентности аниона

В) устойчивость структуры снижается при наличии общих граней и ребер координационных полиэдров

Г) высоко ковалентные и особенно маленькие по размеру катионы стремятся иметь общие анионы

Д) число разных по конституции структурных фрагментов стремится к максимуму

9. Какие типы кристаллов существуют?

А) ионные

Б) ковалентные

В) молекулярные

Г) металлические

Д) аморфные

10. Какие из перечисленных свойств присущи ионным кристаллам?

А) высокая температура плавления

Б) низкая температура плавления

В) хорошая растворимость в воде

Г) хорошая электропроводность

Д) диэлектрические свойства

Расположите вещества в порядке, соответствующем изменению их свойств.

1. Расположите следующие вещества в порядке увеличения их температуры плавления:

А) CaSO_4

Б) MgSO_4

В) BeSO_4

Г) SrSO_4

2. Расположите следующие вещества в порядке увеличения их температуры

плавления:

А) CaCO_3

Б) MgCO_3

В) BeCO_3

Г) SrCO_3

3. Расположите дефекты кристаллической структуры по увеличению их

размерности:

А) линейные

Б) точечные

В) искажения кристаллической решетки

Г) поверхностные

4. Расположите дефекты кристаллической структуры по уменьшению их

размерности:

А) линейные

Б) точечные

В) искажения кристаллической решетки

Г) поверхностные

5. Расположите простые формы низших категорий в порядке увеличения числа

граней:

А) моноэдр

Б) ромбическая пирамида

В) ромбическая призма

Г) пинакоид

6. Расположите простые формы средних категорий в порядке увеличения числа

граней:

- А) тригональная призма
- Б) дитригональная призма
- В) тетрагональная призма
- Г) дитетрагональная призма

Найдите соответствие между элементами двух множеств.

1. Укажите соответствие между значением координационного числа и координационным полиэдром:

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 1) 20 | А) трехшапочная тригональная призма |
| 2) 14 | Б) икосаэдр |
| 3) 12 | В) пентагондодекаэдр |
| 4) 9 | Г) ромбододекаэдр |

2. Укажите соответствие между значением координационного числа и координационным полиэдром:

- | | |
|-------|--------------------------|
| 1) 24 | А) октаэдр |
| 2) 12 | Б) куб |
| 3) 8 | В) притупленный октаэдр |
| 4) 6 | Г) притупленный тетраэдр |

3. Укажите соответствие между видом симметрии и совокупностью элементов симметрии:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1) примитивный | А) L_66P |
| 2) центральный | Б) L_66L_2 |
| 3) планальный | В) L_6 |
| 4) аксиальный | Г) L_6PC |

4. Укажите соответствие между видом симметрии и совокупностью элементов симметрии:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) центральный | А) L_44L_25PC |
| 2) планальный | Б) L_44P |
| 3) аксиальный | В) L_44L_2 |
| 4) планаксиальный | Г) L_4PC |

5. Укажите соответствие между символом Браве и международным символом Германа-Могена

- | | |
|------------|----------|
| 1) P | А) m |
| 2) L_2 | Б) 2 |
| 3) L_22P | В) 222 |
| 4) $3L_2$ | Г) $mm2$ |

6. Укажите соответствие между символом Браве и международным символом Германа-Могена

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) L_2PC | А) mmm |
| 2) $3L_23PC$ | Б) $\frac{2}{m}$ |
| 3) P | В) $mm2$ |
| 4) L_22P | Г) m |

7. Укажите соответствие между типом кристаллической решетки и структурными единицами кристалла

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) атомы | А) металлический |
| 2) катионы и анионы | Б) ионный |
| 3) молекулы | В) молекулярный |
| 4) катионы металла и электроны | Г) ковалентный |

8. Укажите соответствие между типом кристаллической решетки и типом химической связи в кристалле между структурными единицами

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Ван-дер-ваальсово взаимодействие | А) металлический |
|-------------------------------------|------------------|

- 2) ковалентная
- 3) ионная
- 4) металлическая

- Б) ионный
- В) молекулярный
- Г) ковалентный

Внесите дополнения в текстовые фразы, путем вписывания в поле для ввода слова, символа или знака.

Впишите слово в именительном падеже.

1. Группа видов симметрии, обладающих одним или несколькими сходными элементами симметрии (с обязательным учетом осей симметрии порядка, выше двух при одинаковом числе единичных направлений) называется *сингония*

2. Твердое тело, обладающее трехмерной периодической атомной (или молекулярной) структурой и, при определенных условиях образования, имеющее естественную форму правильных симметричных многогранников называется *кристалл*

3. Резкое изменение кристаллической структуры в закономерном ряду химических соединений при сохранении количественного соотношения структурных единиц называется *морфотропия*

4. Взаимное замещение химически различных компонентов в эквивалентных позициях кристаллической структуры называется *изоморфизм*

5. Изменение кристаллической структуры некоторого вещества при изменении термодинамических условий называется *полиморфизм*

6. Координационным полиэдром натрия и хлора в структуре хлорида натрия NaCl является *октаэдр*

7. Координационным полиэдром цинка и серы в структуре сфалерита ZnS является *тетраэдр*

8. Координационным полиэдром титана в структуре перовскита CaTiO₃ является *октаэдр*